

SF 235**Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für HF-Verstärker und UKW-Vorstufen in Basisschaltung.**

Bauform 3 E-Line

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,5 \text{ K/mW}$ **Grenzwerte** gültig für den Betriebstemperaturbereich

| | | |
|---|-----------------|----|
| U_{CBO} | 40 | V |
| U_{CEO} | 25 | V |
| U_{EBO} | 4 | V |
| I_C | 25 | mA |
| P_{tot} ($\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$) | 200 | mW |
| ϑ_a | -40 °C ... +100 | °C |
| ϑ_j | +125 | °C |

Elektrische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

| | | |
|---|------|---------------|
| I_{CBO} (bei $U_{CB} = 40 \text{ V}$) | 0,5 | μA |
| $U_{(BR)CEO}^1$ (bei $I_C = 1 \text{ mA}$) | 25 | V |
| $U_{(BR)EBO}$ (bei $I_E = 10 \mu\text{A}$) | 4 | V |
| I_B (bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$) | 35 | μA |
| $-C_{12b}$ (bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 10,7 \text{ MHz}$) | 0,35 | pF |
| F (bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$, $Y_G = (5 - j 3,3) \text{ mS}$) | 4 | dB |
| h_{21b} (bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 30 \text{ MHz}$) | typ. | 7,2 ps |
| ω | | |
| f_{Y21b} (bei $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$) | typ. | 740 MHz |

1) Messung erfolgt impulsmäßig